

# 数字电路与数字系统实验

实验名称	exp07 存储器
院系	计算机科学与技术系
学生姓名	
学号	
班级	数字电路与数字系统实验1班
邮箱	
实验时间	2020 年 10 月 12 日

# 目录

1	实验目的	2
2	实验原理	2
3	实验环境/器材	2
4	程序代码+实验过程+测试方法	2
4.1	实验7.2 思考题 . . . . .	2
4.2	实验7.4 不同方式实现两个存储器 . . . . .	3
5	实验结果	6
6	遇到的问题及解决办法	7
7	得到的启示	8
8	意见和建议	8

## 1 实验目的

- 复习存储器 上学期貌似只学过寄存器没学过存储器
- 学习用Verilog实现存储器
- 了解FPGA开发板上的存储器的特性

## 2 实验原理

将数据地址送入输入地址端或输出地址端，存储器根据写使能信号读取相应地址对应数据，并进行写入或读出。

## 3 实验环境/器材

- Quartus编辑器和DE10-Standard开发平台
- FPGA开发板

## 4 程序代码+实验过程+测试方法

### 4.1 实验7.2 思考题

该存储器的行为会发生变化。

连续赋值语句会把输出地址对应的数据立即输出。非阻塞赋值语句会等到写使能无效的时候，再去取输出地址对应的数据，并输出。

例如当输入地址和输出地址为同一地址时，当写使能有效时，连续赋值语句会把写入的数据立即送到输出总线上；非阻塞赋值语句会等到写使能无效的时候，再取输出输出地址对应的数据。

也就是说，使用连续赋值语句，会让存储器的输出不受时钟和使能端的控制。使用非阻塞赋值语句，会让存储器的输出受时钟和使能端的控制。

## 4.2 实验7.4 不同方式实现两个存储器

先说明一下FPGA开发板上的按钮分配。因为要在一个工程里实现两个存储器，所以用一个控制开关KEY[1]选择RAM1（KEY[1]=1）或者RAM2（KEY[1]=0），并用一对LEDR来显示我们选择了哪个存储器。然后我们把KEY[0]作为共用的写使能信号（按下为写使能有效）、把SW[9:8]作为共用的数据输入、把SW[7:4]作为共用的输入（写）地址、把SW[3:0]作为共用的输出（读）地址。读数据时，我们把RAM1上的数据输出到HEX1和HEX0上、把RAM2上的数据输出到HEX5和HEX4上。

不用SW[9:8]作为两个使能信号、KEY[3:0]作为4位的数据输入，是因为懒得对Switch开关进行按键消抖（参见条目“遇到的问题及解决办法”）

为了精简代码，我封装了一个4位二进制输出到七段数码管的模块：

```
1 module seg_7_out(in_4bit, out_seg);
2     input [3:0] in_4bit;
3     output reg [6:0] out_seg;
4
5     always @ (in_4bit) begin
6         case (in_4bit)
7             0 : out_seg = 7'b1000000;
8             /* 中间case省略不贴出 */
9             15 : out_seg = 7'b0001110;
10            default: out_seg = 7'bx;
11        endcase
12    end
13 endmodule
```

RAM1的代码和实验7.2题目中给出的代码几乎一样，这里只描述一下不一样的地方。首先是函数头和我们另外声明的变量（input和output声明省略）：

```
1 module rams_16(clk, en, we, inaddr, outaddr, din, dout_h,
2     dout_l);
3     reg [7:0] ram [15:0];
4     wire [7:0] dout_vec;
5     wire [6:0] dout_h_tmp, dout_l_tmp;
```

dout\_h和dout\_l是输出数据的高4位和低4位。 dout\_vec用来存储从存储器中读出的数据，经过转换后输出到七段数码管上：

```
1  assign dout_vec = ram[outaddr];
2  seg_7_out s1(dout_vec[7:4], dout_h_tmp);
3  seg_7_out s2(dout_vec[3:0], dout_l_tmp);
4
5  always @ (posedge clk) begin
6      if (en && we) ram[inaddr] <= {6'b0, din};
7      else if (en && !we) begin
8          dout_h <= dout_h_tmp;
9          dout_l <= dout_l_tmp;
10     end else begin
11         dout_h <= dout_h;
12         dout_l <= dout_l;
13     end
14 end
```

使用非阻塞赋值语句而不是连续赋值语句的原因参见条目“遇到的问题及解决办法”中，关于IP核生成的存储器读写延迟问题的讨论。

RAM2的代码也用同样的方法实现：

```
1  wire [7:0] din_full;
2  wire [7:0] dout_vec;
3  wire [6:0] dout_h_tmp, dout_l_tmp;
4
5  assign din_full = {6'b0, din};
6  assign ram_en = en & we;
7
8  ram2port r1(
9      .clock(clk),
10     .data(din_full),
11     .rdaddress(outaddr),
12     .wraddress(inaddr),
13     .wren(ram_en),
14     .q(dout_vec));
15  seg_7_out s1(dout_vec[7:4], dout_h_tmp);
16  seg_7_out s2(dout_vec[3:0], dout_l_tmp);
17
```

```

18  always @ (posedge clk) begin
19      if (en && !we) begin
20          dout_h <= dout_h_tmp;
21          dout_l <= dout_l_tmp;
22      end else begin
23          dout_h <= dout_h;
24          dout_l <= dout_l;
25      end
26  end

```

这里唯一要注意的是使能信号，因为是调用系统生成的模块来进行写入存储器，所以必须当存储器使能和写使能同时有效时才能进行写入。RAM1的代码可以在 always程序块里进行两次判断，再用与运算符得到的判断结果来决定是否写入，而RAM2必须先对两个使能信号进行运算，然后把结果传入调用模块里。

## • 测试方法

简单贴一下测试代码：

```

1      KEY[1] = 1;
2      KEY[0] = 0; // write
3      SW[9:8] = 4'h0;
4      SW[7:4] = 4'h3;
5      SW[3:0] = 4'h1;
6      #5;
7      KEY[0] = 1; // read
8      #5;
9      KEY[0] = 0; // write
10     SW[9:8] = 4'h3;
11     SW[7:4] = 4'h7;
12     SW[3:0] = 4'h7;
13     #5;
14     KEY[0] = 1; // read
15     #5;
16     SW[3:0] = 4'h3;
17     #5;
18

```

```

19  /* 省略重复的代码:
20  把上面的代码复制粘贴下来, 再把KEY[1] = 1改成KEY[1] = 0 */
21
22      $stop;
23 end
24
25 always
26 begin
27     #0.02 CLOCK_50 = 1; #0.5;
28     CLOCK_50 = 0; #0.48;
29 end

```

然后看仿真运行的结果。主要关注一下, 当我们对RAM1 操作的时候, 并不会影响到RAM2的存储状态, 反之同理:

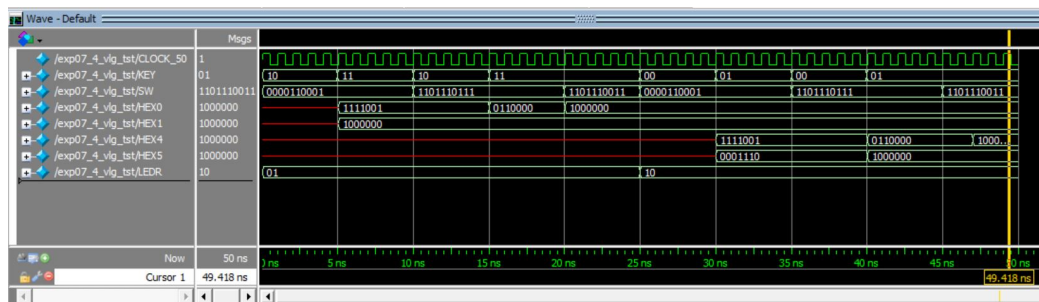


图 1: 仿真运行结果

## 5 实验结果

FPGA开发板运行结果展示:

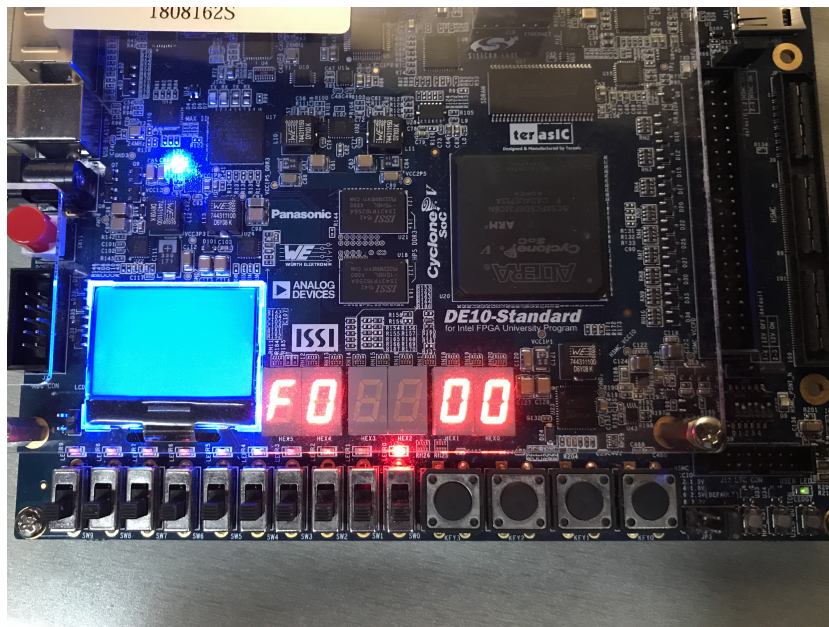


图 2: 下载运行

## 6 遇到的问题及解决办法

- 从读取输出地址到七段数码管输出之间至多只能有一个非阻塞赋值语句，否则会有延迟
- 因为写入的是2位的数据，所以我们最好把写入地址对应的8位数据的高6位清零
- 用IP核生成的存储器读写数据会有两个系统时钟周期的延迟。当输入地址和输出地址相同且写使能有效时，记写入之前该地址对应的数据为a，写入之后该地址对应的数据为b。如果该存储器的输出不受时钟和使能端的控制，那么它会先输出一个系统时钟周期的a，此后再输出b。所以需要使用非阻塞赋值语句避免输出a



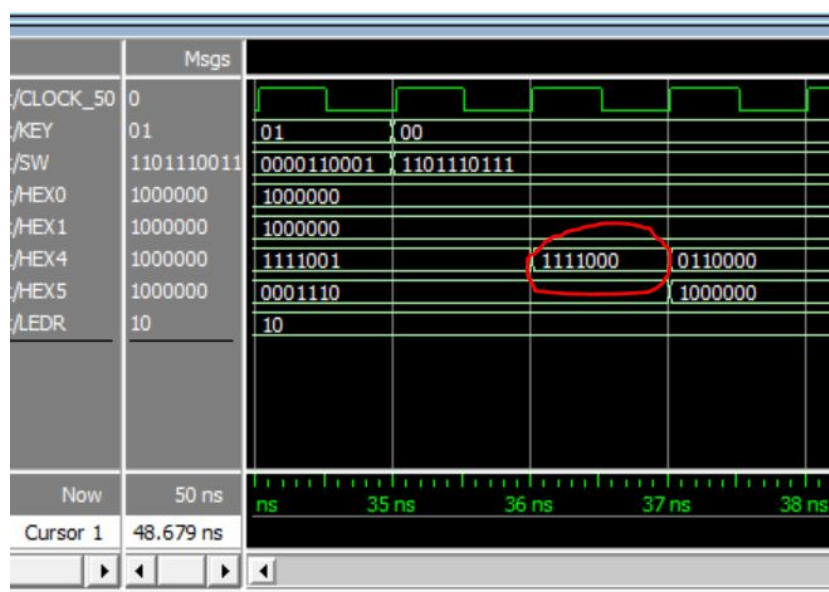


图 3: 输出了应该被覆盖的数据

- 如果用Switch开关作为存储器使能和写使能的话，需要对其进行按键消抖（我也不知道为什么Switch开关拨定之后它还是会抖动，明明拨定了却还是会同时读写两个存储器，test bench没问题但下载运行就有问题，改成用KEY按钮控制使能端就没问题了）

## 7 得到的启示

模块化编程能让代码精简不少，但Verilog语言的模块用起来总感觉有各种说不清的限制。单单是“只能在同一个always 程序块里对同一个变量赋值”就已经很让人头疼了。而且，为了解决这个问题，就不得不多创建几个中间变量，还需要尽量少用非阻塞赋值语句对这些变量进行赋值（否则会有很严重的延迟）。所以比起软件语言而言，Verilog确实有一些不便之处。

## 8 意见和建议

- 意见和建议（×）题目纠错（✓）

- 实验7.1的表7-2: RAM代码中, 声明ram变量那一行应该是 [RAM\_WIDTH-1:0]
- 实验7.2.1的表7-3: 存储器实例代码中, dout0和dout1 重复声明两遍, 可以直接声明为 output reg [7:0] dout0, dout1
- 实验7.3.2对RAM实例化的代码中, 应该是“.rdaddress(outaddr)”